

单片开关电源的电磁兼容性设计

沙占友 ,王彦朋 ,唱春来 ,张英

(河北科技大学 ,石家庄 050054)

摘要 介绍了单片开关电源的电磁兼容性(EMC)设计,内容包括对电磁干扰波形和电路模型进行分析,以及EMI滤波器的电路设计。

关键词 电磁兼容性 ;电磁干扰 ;共模 ;串模 ;EMI 滤波器

中图分类号 :TN86 ,TN03

文献标识码 :B

文章编号 :1001-1390(2000)08-0017-03

The electromagnetic compatibility (EMC) design of single-chip switching power supply

Sha Zhenyou ,Wang Yanpeng ,Chang Chunlai ,Zhang Ying

(Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang 050054 ,China)

Abstract The paper introduces the EMC design of single-chip switching power supply. In the first, it analysis the EMI wave and circuit model and then presents the circuit design of EMI filter.

Key words EMC ;electromagnetic interference(EMI) ;common mode ;different mode ;EMI filter

0 引言

单片开关电源工作在高频、高压、大电流的开关状态,所产生的电磁干扰亦分共模干扰、串模干扰两种,并以传导或辐射的方式向外部传播。单片开关电源的电磁兼容性设计,就是要把电磁干扰衰减到允许限度之内,使之不影响电子设备的正常工作。

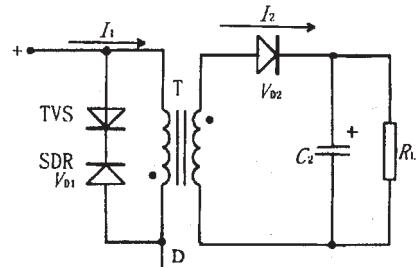
1 电磁干扰的波形分析

反馈式单片开关电源的简化电路和电磁干扰波形分别如图 1a、图 1b 所示。

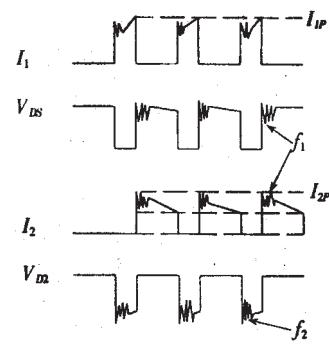
图 1a 中 V_I 为直流输入电压 I_1 为高频变压器的初级电流。设 TOPSwitch 漏-源极电压为 V_{DS} ,输出整流管上的电压为 V_{D2} 。 I_2 是次级电流 R_L 为负载。图 1b 中分别给出 I_1 , V_{DS} , I_2 和 V_{D2} 的电磁干扰波形。

下面对这 4 种波形加以分析。

初级电流 I_1 是在 TOPSwitch 导通时开始形成并沿着斜坡上升,达到峰值 I_{1P} 。 I_{1P} 值由直流输入电压 V_I 、初级电感 L_P 、开关频率 f 和占空比 D 来决定。该梯形电流波形的基频为开关频率,谐波即干扰波形。初级串模干扰电流经过初级绕组、TOPSwitch 和 V_I 形成回路。当电流环路面积较大时 I_1 还能向外辐射



(a) 简化电路



(b) 4 种电磁干扰波形

图 1 单片开关电源简化电路及电磁干扰波形

共模干扰。

V_{DS} 电压波形的特点是 , 其电压变化率(dV/dt) 很高 , 受变压器漏感、TOPSwitch 输出电容和变压器分布电容等分布参数的影响 , V_{DS} 在 $f_1=3\text{MHz} \sim 12\text{MHz}$ 的频率范围内形成振铃。

当 TOPSwitch 关断时 , 次级上就有电流 I_2 通过 , 并且从峰值 I_{2p} 开始 , 然后线性下降 , 下降速率由次级电感 L_s 和输出电压 V_o 来决定。下降过程中形成

的振铃 , 在时间上与 V_{DS} 相对应 , 振铃频率仍为 f_1 。

V_{D2} 也具有电压变化率高、上升沿和下降沿陡峭的特点。其峰值电压由变压器和输出整流管的分布电容所决定。振铃干扰波形的频率变化是 $f_2=20\text{MHz} \sim 30\text{MHz}$ 。

2 造成电磁干扰的电路模型

2.1 共模干扰的电路模型

造成共模干扰的电路模型如图 2 所示。

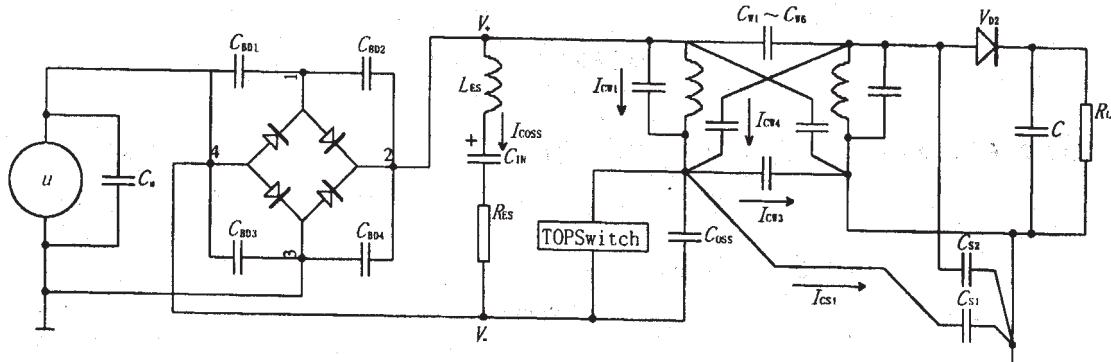


图 2 造成共模干扰的电路模型

共模干扰主要是由漏-源极电压 V_{DS} 和输出整流管电压 V_{D2} 而产生的。图 2 中 C_u 是与交流电源输入端相并联的耦合电容 , $C_{BD1} \sim C_{BD4}$ 是整流桥中 4 只整流管的等效电容 , C_{IN} 为输入滤波电容 , 其等效串联电感和等效串联电阻分别用 L_{ES} , R_{ES} 表示 , $C_{W1} \sim C_{W6}$ 均为高频变压器的分布电容。其中 C_{W1} 和 C_{W6} 分别为初级、次级绕组的分布电容 , 二者组合起来可产生 $400\text{kHz} \sim 2\text{MHz}$ 的谐波频率。 $C_{W2} \sim C_{W5}$ 是初级、次级绕组之间的各种分布电容。 C_{OSS} 为 TOPSwitch 的输出电容。 C_{S1} 和 C_{S2} 依次为漏极、次级对地的分布电容。上述电容会造成 5 个干扰电流 $I_{CS1}, I_{CW1}, I_{CW3}, I_{COS}$ 和 I_{CW4} 。这 5 个电流相叠加后 , 有一部分被抵消掉 , 剩下的高频电流即形成共模干扰。

共模干扰可由 EMI 滤波器中的共模扼流圈进

行抑制。共模扼流圈的电感量通常取 $10 \sim 33\text{mH}$ 。为减小分布电容 , 印制板上的相关导线应尽量短捷。

2.2 串模干扰的电路模型

串模干扰的电路模型如图 3a 所示 , 图 3b 为其等效电路。图 3a 中 C_D 为串模电容 , L_D 和 L'_D 是两个串模扼流圈。 R_{ES} 为输入滤波电容 C_{IN} 的等效串联电阻。图 3b 中 , 两条电源线上对地的电压用 V_S 表示 , 正半周时电压极性如图所示。不难看出 , 串模干扰电流的方向是从一条电源线流入单片开关电源 , 再从另一条电源线流出的。由 C_D, L_D 和 L'_D 构成的串模干扰滤波器能对串模干扰起到抑制作用。

举例说明 , 在 $7.5\text{V}, 15\text{W}$ 开关电源模块中 , 实取 $C_D=0.1\mu\text{F}$, $C_{IN}=33\mu\text{F}$, $R_{ES}=0.375\Omega$, $L_D=L'_D=74\mu\text{H}$ 。 L_D 和 L'_D 可以是分立电感 , 也可以是从共模干扰扼流

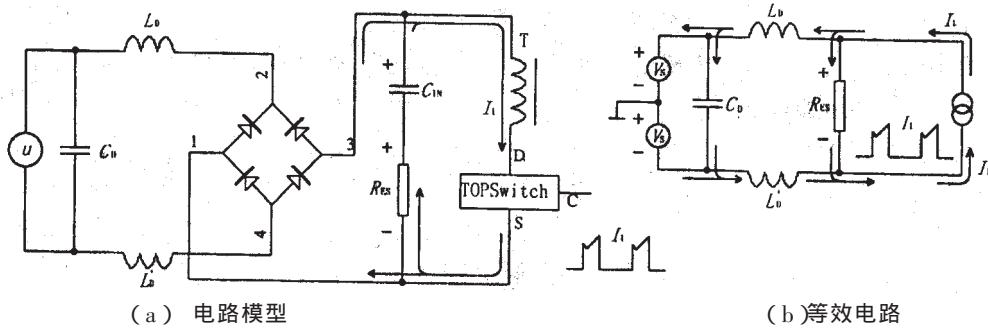


图 3 串模干扰的电路模型

圈上分离出来的等效串联电感。加串模干扰滤波器后，串模干扰的基波电压为 59.3mV，二次谐波降为 43.0mV。

注意，在测量共模扼流圈一个绕组的等效串模电感时，应将另一绕组短路，并且要将测量值除以 2 才是 L_L （或 L'_D ）电感量。

3 EMI 滤波器的电路设计

3.1 单片开关电源常用的 EMI 滤波器电路

为减小体积和降低成本，单片开关电源一般采用简易式单级 EMI 滤波器，典型电路如图 4a、图

4b、图 4c、图 4d 所示，图 4 中 L 为共模扼流圈。图 4a 中与图 4b 中的电容器 C 能滤除串模干扰，区别仅是图 4a 中将电容器 C 接在输入端，图 4b 则接到输出端。图 4c、图 4d 所示电路较复杂，抑制电磁干扰的效果更佳。图 4c 中的 L 、 C_1 和 C_2 用来滤除共模干扰， C_3 和 C_4 滤除串模干扰。 R 为泄放电阻，可将 C_3 上积累的电荷泄放掉，避免因电荷积累而影响滤波特性；断电后还能使电源的进线端 L、N 不带电，保证用户的安全。图 4d 则是把共模干扰滤波电容 C_2 和 C_4 接在输出端。

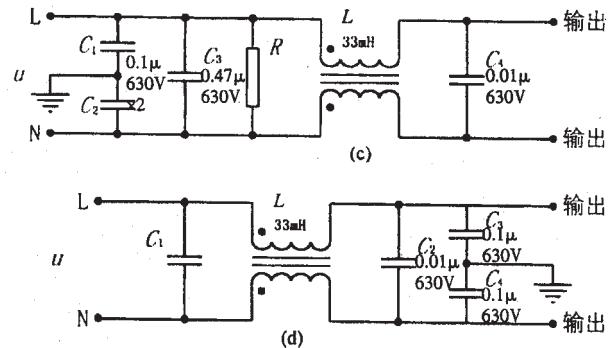
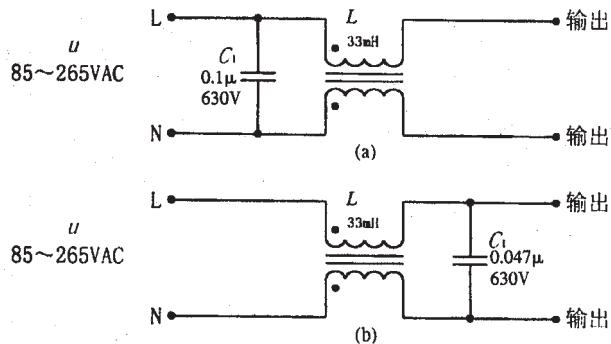


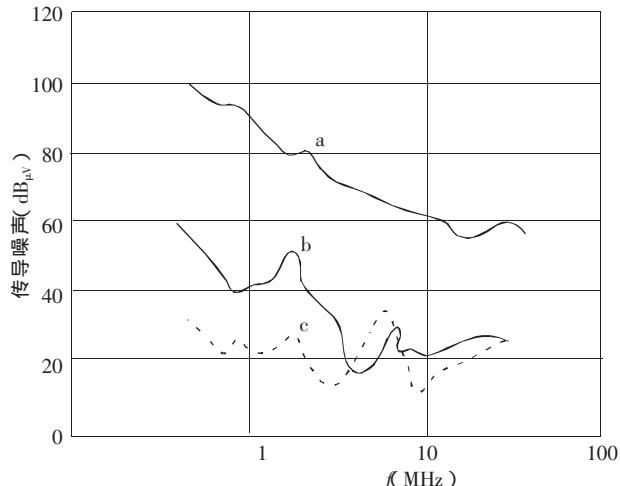
图 4 单片开关电源常用的 EMI 滤波器电路

EMI 滤波器能有效抑制单片开关电源的电磁干扰。图 5 中 a 为不加 EMI 滤波器时开关电源上 0.15MHz~30MHz 传导噪声的波形（即电磁干扰峰值包络线）。图 5 中 b 是插入如图 4c 所示 EMI 滤波器后的波形，电磁干扰大约被衰减 40dB_{μV}。图 5 中 c 为加上如图 4d 所示 EMI 滤波器后的波形，能衰减约 50 dB_{μV}~70 dB_{μV}。显然，后一种 EMI 滤波器的效果最佳。

3.2 元器件选择

滤波电容应选自谐振频率很高的陶瓷电容器。电容器的耐压值应足够高，通常选 630V。输出端滤波电容上还加有尖峰电压，其耐压值可选 1000V。扼流圈分共模、串模两种，通常采用共模扼流圈。它实际是由共模电感、串模泄漏电感这两部分构成，因此它对串模干扰也有一定的抑制作用。其优点是能同时起到共模扼流圈、串模扼流圈两种作用，而成本并未增加。共模扼流圈的线径要能承受可能发生的浪涌电流。串模扼流圈仅适用于 5W 以下的低功率开关电源，它是两个分立的铁氧体磁环线圈或螺管线圈构成的。

参 考 文 献：



(a) 不加 EMI 滤波器 (b) 加 EMI 滤波器 c (c) 加 EMI 滤波器 d;

图 5 加 EMI 滤波前、后干扰波形的比较

[1] 美国 Power 公司产品资料, 1998.

[2] 沙占友. 实用数字化测量技术 [M]. 国防工业出版社, 1998.

作者简介：

沙占友(1944-)，男，教授，1968 年毕业于南开大学，主要从事数字化测量及仪器仪表领域的教学与科研工作。已出版专著 14 部，发表学术论文 120 余篇。

收稿日期 2000-06-04

(周广义 编发)